
	<h2>SI7882DP-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7882DP-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 12V 13A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7882DP-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 41193 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7882DP-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 13A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	41193 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 12V 13A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5.5 mOhm @ 17A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7882DP-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7882DP-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7882DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7882DP-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7882DP VISHAY SI7882DP VISHAY</p>	 <p>SI7880DP-T1-GE3 V SI7880DP-T1-GE3 V</p>	 <p>SI7884BDP VISHAY SI7884BDP VISHAY</p>	 <p>SI7880DP-T1 VISHAY SI7880DP-T1 VISHAY</p>
 <p>SI7882DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7882DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7880DP-T1-E3 VISHAY SI7880DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI7882DP-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 12V 13A PPAK SO-8</p>

heiße Teile

Mehr

 SI7866ADP-T1-GE3	 SI7866ADP-T1-GE3	 SI7866DP-T1	 SI7866DP-T1-E3	 SI7866DP-T1-GE3
 SI7868ADP	 SI7868ADP-T1-E3	 SI7868ADP-T1-E3	 SI7868ADP-T1-GE3	 SI7868ADP-T1-GE3
 SI7868DP-T1	 SI7868DP-T1-E3	 SI7868DP-T1-GE3	 SI786LG-T1	 SI786LG-T1-E3
 SI7872DP	 SI7872DP-T1-E3	 SI7872DP-T1-E3	 SI7872DP-T1-GE3	 SI7872DP-T1-GE3
 SI7880ADP-T1-E3	 SI7880ADP-T1-E3	 SI7880ADP-T1-GE3	 SI7880ADP-T1-GE3	 SI7880DP-T1-GE3
 SI7882DP-T1-E3	 SI7882DP-T1-GE3	 SI7882DP-T1-GE3	 SI7884BDP	 SI7884BDP-T1-E3
 SI7884BDP-T1-E3	 SI7884BDP-T1-GE3	 SI7884BDP-T1-GE3	 SI7884DP-T1-E3	 SI7884DP-T1-GE3
 SI7886ADP-T1-E3	 SI7886ADP-T1-E3	 SI7886ADP-T1-GE3	 SI7886ADP-T1-GE3	 SI7886DP
 SI7886DP-T1	 SI7886DP-T1-E3	 SI7886DP-T1-GE3	 SI7888DP-T1-E3	 SI7888DP-T1-E3
 SI7888DP-T1-GE3	 SI7888DP-T1-GE3	 SI7892ADP-T1-E3	 SI7892ADP-T1-GE3	 SI7892ADP-T1-GE3.

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited